

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 3 0 日
Date of Application:

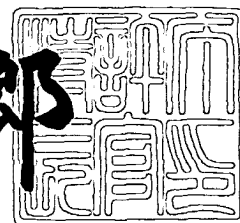
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 5 5 2 1 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 5 5 2 1 0]

出 願 人 株 式 会 社 東 芝
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



【書類名】 特許願

【整理番号】 A000202317

【提出日】 平成14年 8月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明の名称】 露光装置の検査方法および露光装置

【請求項の数】 21

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横
 浜事業所内

 【氏名】 福原 和也

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横
 浜事業所内

 【氏名】 井上 壮一

【特許出願人】

 【識別番号】 000003078

 【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

 【識別番号】 100058479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴江 武彦

 【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

 【識別番号】 100084618

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 露光装置の検査方法および露光装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の設置手段上に設置されたフォトマスクを照明光学系により照明し、前記フォトマスクのパターンの像を、投影光学系を介して、第 2 の設置手段上に設置された基板上に投影する露光装置の検査方法であって、

前記第 2 の設置手段上に前記基板として検査用の感光基板を設置し、この感光基板の表面と前記照明光学系の二次光源の面とが光学的に共役な状態で、前記感光基板を二重露光する工程であって、前記二重露光の一方においては、前記投影光学系の瞳の端を含まない第 1 の領域を照明し、他方においては、前記投影光学系の瞳の端を含む第 2 の領域を照明し、かつ、前記第 1 の領域および前記第 2 の領域として互いに重ならない領域を選ぶ工程と、

前記感光基板を現像して得られたパターンに基づいて、前記露光装置の照明軸ずれを検査する工程と

を有することを特徴とする露光装置の検査方法。

【請求項 2】

前記感光基板の表面と前記照明光学系の二次光源の面とを光学的に共役な状態にするために、前記照明光学系と前記投影光学系との間、または前記投影光学系と前記感光基板との間に、表面にパターンが形成されたパターン部材を設けることを特徴とする請求項 1 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 3】

前記パターン部材は検査用フォトマスクであり、かつ、該検査用フォトマスクは、そのパターンが形成された面が、前記投影基板の表面と光学的に共役でない状態に、前記第 1 の設置手段上に設置されることを特徴とする請求項 2 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 4】

前記検査用フォトマスクの前記パターンは、露光光に対して透明な円形パターンを含むことを特徴とする請求項 3 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 5】

前記円形パターンが設けられた面を前記二次光源の面に向けて、前記検査用フォトマスクを前記第 1 の設置手段上に設置することにより、前記検査用フォトマスクの前記開口パターンが形成された面と前記感光基板の表面とを光学的に共役でない状態にすることを特徴とする請求項 4 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 6】

前記開口パターンの直径を、 $40\mu\text{m}$ 以上 $80\mu\text{m}$ 以下の範囲に設定することを特徴する請求項 5 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 7】

前記円形パターンが設けられた面を前記投影光学系の瞳に向けて、前記検査用フォトマスクを前記第 1 の設置手段上に設置することを特徴とする請求項 4 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 8】

前記投影光学系の瞳と前記感光基板の表面との間の距離を制御することによって、前記検査用フォトマスクの前記開口パターンが形成された面と前記感光基板の表面とを光学的に共役でない状態にすることを特徴とする請求項 7 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 9】

前記感光基板として、露光光に対して透明な基板と、該基板の前記露光光が入射する側の面と反対の面に設けられ、前記露光光を反射する反射膜とを含むものを用いることを特徴とする請求項 7 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 10】

前記開口パターンの直径を、 $1\mu\text{m}$ 以上 $20\mu\text{m}$ 以下の範囲に設定することを特徴する請求項 7 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 11】

前記感光基板は、シリコンウェハと、該シリコンウェハ上に塗布されたフォトリジストとを含むことを特徴とする請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 12】

前記パターン部材はレンズ部材であり、かつ、該レンズ部材は、前記照明光学系の二次光源の面と前記投影光学系との間の光路中、または前記投影光学系と前記感光基板との間の光路中に設置されることを特徴とする請求項 2 に記載の露光装置の製造方法。

【請求項 13】

前記二次光源により、前記第 2 の領域を照明して、前記感光基板を露光する際に、前記二次光源の照明形状を輪帯状にすることを特徴とする請求項 1 ないし 12 のいずれか 1 項に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 14】

前記二次光源により、前記第 2 の領域を照明して、前記感光基板を露光する際に、前記二次光源の照明形状を 3 方向以上に輝度の極大をもつ形状にすることを特徴とする請求項 1 ないし 12 のいずれか 1 項に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 15】

前記投影光学系の瞳面における前記二次光源の照明形状は、

$$NA_{i1} > NA_{in} > NA_{i2}$$

NA_{in} : 前記投影光学系の入射側開口数

NA_{i1} : 前記照明光学系の出射側開口数

NA_{i2} : 前記二次光源の内周に対応する光の入射角を開口数の次元で表した数値

の不等式を満たすことを特徴とする請求項 13 または 14 に記載の露光装置の検査方法。

【請求項 16】

フォトマスクが設置される第 1 の設置手段と、

この第 1 の設置手段上に設置された前記フォトマスクに形成されたパターンを照明するための照明光学系と、

基板が設置される第 2 の設置手段と、

この第 2 の設置手段上に設置された前記基板上に、前記フォトマスクのパターンの像を投影するための投影光学系と、

前記照明光学系の二次光源の面と前記投影光学系との間の光路中、または前記

投影光学系と前記基板との間の光路中に配置されるレンズ部材とを具備してなることを特徴とする露光装置。

【請求項 17】

前記レンズ部材は、前記フォトマスクの表面の上方に該表面に対して垂直な方向、または前記基板の表面の上方に該表面に対して垂直な方向に、所定距離離れた位置に設置されることを特徴とする請求項 16 に記載の露光装置。

【請求項 18】

前記所定距離は、前記レンズ部材の焦点距離と実質的に同じ距離であることを特徴とする請求項 17 に記載の露光装置。

【請求項 19】

前記レンズ部材は、主面を含む基板と、該基板の前記主面上に設けられた複数のレンズとを含み、かつ、前記基板の前記主面と前記感光基板の表面とが平行になるように、前記レンズ部材は設置されることを特徴とする請求項 16 ないし請求項 18 のいずれか 1 項に記載の露光装置。

【請求項 20】

前記基板の前記主面のうち、前記複数のレンズが設けられていない領域は、露光光を遮断することを特徴とする請求項 19 に記載の露光装置。

【請求項 21】

前記レンズ部材を露光光の光路外に待避する待避手段をさらに備えていることを特徴とする請求項 16 ないし 20 のいずれか 1 項に記載の露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体装置の製造プロセスに使用される露光装置の検査方法および該検査方法を簡便に行うための露光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体デバイスの歩留まりを高い状態に維持するために重要なことの一つとして、光リソグラフィの工程に用いられる露光装置を正常な結像状態に保っておく

ことがあげられる。そのためには、簡単な方法で露光装置の状態を検査・監視する技術が要求される。露光装置においては、二次光源の形状や輝度の分布が変わると、マスクパターンの基板面への結像に関する特性が変化する。したがって、露光装置の照明光学系についても常に検査し、同じ状態を保つ必要がある。

【0003】

露光装置の結像特性に影響を及ぼす照明光学系の誤差要因としては、二次光源の形状や輝度の分布の他に、フォトマスクに入射する照明光が全体として斜めに傾く現象（照明軸ずれ）がある。

【0004】

図19を用いて照明軸ずれの影響を説明すると、照明軸ずれが起きていない状態（図19（a））では、ウェハ上にレジストが塗布された基板（感光基板）100が像面101にある状態（ベストフォーカス）で、光102Aで露光して得られるレジストパターン103Aと、ベストフォーカスから多少デフォーカスした状態で、光102B、102Cで露光して得られるレジストパターン103B、103Cとの間には位置ずれがないため、フォーカス変動に対して強固な装置となる。一方、照明軸ずれが起きている状態（図19（b））においては、感光基板100のデフォーカスによってレジストパターン103A～103Cの形成位置が横にずれてしまい、露光領域全体として所望のパターンができにくくなる恐れがある。これは、不良品の数を増加させる原因となる。

【0005】

このような不都合は、照明軸ずれを検査し、照明軸ずれの存在を確認したら、露光装置を停止してメンテナンスを行うことによって、未然に防止することができる。以下、二次光源の形状、輝度分布、照明軸ずれの検査を、まとめて「照明光学系の検査」と表記する。

【0006】

半導体デバイスの製造装置の検査方法としては、装置を停止させないで短時間で簡便に計測する方法が望ましい。このような条件を満たす照明光学系の検査法として、周囲を遮光した開口パターン（ピンホールパターン）を用い、この開口パターンを感光基板の表面と共役ではない位置に設置して露光を行うことによ

て感光基板上に二次光源の像を形成し、二次光源の形状や輝度分布を計測する方法が、USP 5973771や、Proceedings of SPIE vol.3334, pp. 281-288に開示されている。これらの方法では、開口パターンをピンホールカメラのレンズとして機能させることにより、感光基板上に二次光源の像を転写させ、転写像を観察することにより検査が行われる。一方、単純な開口パターンではなく、ゾンプレートを使用して二次光源の転写像を取得し検査する方法が、USP 6048651に開示されている。

【0 0 0 7】

しかしながら、上記の公報等で開示されたいずれの方法でも、照明軸ずれを知ることとはできない。何故なら、感光基板上に形成されるパターンは二次光源の輝度分布を表す像であり、投影光学系に関する情報は何も含んでいないため、投影光学系に対して照明光の垂直性が保たれているか否かを判断することができないからである。

【0 0 0 8】

二次光源の形状や輝度分布を計測すると同時に、照明軸ずれも計測する方法として、周囲を遮光した開口パターンの内部に回折格子を設置したパターン（グレーティングピンホールパターン、例えば図 2 0）を用いる方法が、特開 2 0 0 0 - 2 1 7 3 2 に開示されている。この方法では、回折格子により発生した回折光を利用し、投影光学系の開口数を規定する絞りの位置を二次光源の輝度分布と同時に転写させる。

【0 0 0 9】

図 2 1 は、この露光によって感光基板上に形成されるパターンの一例である。0 次回折光の像 1 1 0 は二次光源の輝度分布の情報を含む。1 次回折光の像（輪郭像）1 1 1 は絞りの輪郭の位置の情報を含んでいる。0 次回折光の像 1 1 0 の中央と絞りの輪郭像 1 1 1 の中央との間の位置のずれが、照明軸ずれの量をあらわす。

【0 0 1 0】

しかしながら、この方法では、検査に使用するフォトマスク上の回折格子の周期を非常に小さくしなければならない。この点について、以下、具体的に説明す

る。

【0011】

照明光学系の検査に用いるフォトマスク上の回折格子の周期は、回折光に関する二つの制限条件、すなわち（１）０次回折光の像と１次回折光の像とが重ならないこと、（２）１次回折光が絞り位置（瞳の端）を通過すること、を満たしている必要がある。

【0012】

例えば、露光波長が 193 nm、投影縮小率が 1/4 の露光装置において、投影光学系の射出側開口数（NA）を 0.68、コヒーレンスファクタ（ σ ）を 0.75 とした状態を検査する場合、上記二つの条件を満たすために必要な適切な回折格子の周期は約 0.64 μm となる。これは感光基板上のスケールに換算すると、ハーフピッチ 0.08 μm となり、現在量産されている半導体デバイスにおいて使用される繰り返しパターンの最小線幅、0.13～0.11 μm よりも小さい。

【0013】

このような微細なパターンをもつフォトマスクの作成は高度な技術が必要であり、コストがかかる。したがって、従来の技術では、露光装置の照明軸ずれをコストをかけずに検査することは困難である。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】

上述の如く、二次光源の形状や輝度分布を計測すると同時に、照明軸ずれも計測する露光装置の検査方法として、周囲を遮光した開口パターンの内部に回折格子を設置したパターンを用いる方法が知られていたが、検査に使用するフォトマスクの製造コストが高いという問題がある。

【0015】

本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、コストをかけずに照明軸ずれの検査を行える露光装置の検査方法および露光装置を提供することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通りである。すなわち、上記目的を達成するために、本発明に係る露光装置の検査方法は、第1の設置手段上に設置されたフォトマスクを照明光学系により照明し、前記フォトマスクのパターンの像を、投影光学系を介して、第2の設置手段上に設置された基板上に投影する露光装置の検査方法であって、前記第2の設置手段上に前記基板として検査用の感光基板を設置し、この感光基板の表面と前記照明光学系の二次光源の面とが光学的に共役な状態で、前記感光基板を二重露光する工程であって、前記二重露光の一方においては、前記投影光学系の瞳の端を含まない第1の領域を照明し、他方においては、前記投影光学系の瞳の端を含む第2の領域を照明し、かつ、前記第1の領域および前記第2の領域として互いに重ならない領域を選ぶ工程と、前記感光基板を現像して得られたパターンに基づいて、前記露光装置の照明軸ずれを検査する工程とを有することを特徴とする。

【0017】

本発明では、照明光学系の二次光源の面と感光基板の表面とを光学的に共役な状態にして、投影光学系の瞳の端を含まない第1の領域を照明して感光基板を露光し、投影光学系の瞳の端を含む第2の領域を照明して感光基板を露光するという二重露光を行い、該二重露光が行われた感光基板を現像して得られるパターンに基づいて、露光装置の照明軸ずれを検査する。

【0018】

ここで、上記二つのパターンのうち前者の露光に対応したパターン（第1のパターン）は、照明光学系の情報は含むが、投影光学系の情報を含まない。一方、後者の露光に対応したパターン（第2のパターン）は照明光学系および投影光学系の情報を含む。具体的には、第2のパターンの輪郭は、投影光学系の瞳の端の情報を含み、第2のパターンのうち上記輪郭よりも内側のパターンは、照明光学系の情報を含んでいる。

【0019】

したがって、照明軸のずれ（照明光学系と投影光学系との光学的なずれ）の検

査は、第1のパターンと第2のパターンとを比較することにより可能となる。そして、このような検査は、高価なグレーティングピンホールを用いずに実施できるので、コストをかけずに済む。これらの点については、発明の実施の詳細においてさらに説明する。

【0020】

また、本発明に係る露光装置は、フォトマスクが設置される第1の設置手段と、この第1の設置手段上に設置された前記フォトマスクに形成されたパターンを照明するための照明光学系と、基板が設置される第2の設置手段と、この第2の設置手段上に設置された前記基板上に、前記フォトマスクのパターンの像を投影するための投影光学系と、前記照明光学系の二次光源の面と前記投影光学系との間の光路中、または前記投影光学系と前記基板との間の光路中に配置されるレンズ部材とを具備してなることを特徴とする。

【0021】

このような構成であれば、照明光学系の二次光源の面と感光基板の表面とを光学的に共役な状態にするための部材である、レンズ部材を予め備えているので、本発明の検査方法を簡便に行えるようになる。

【0022】

本発明の上記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記載および添付図面によって明らかになるであろう。

【0023】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。

【0024】

（第1の実施形態）

図1は、本発明の第1の実施形態に係る露光装置の検査方法において使用する検査用フォトマスク（以下、単にフォトマスクという。）を示す平面図である。

【0025】

フォトマスク1は、厚さが6.35mm（0.25インチ）の透明基板としての石英基板（不図示）と、この石英基板上に順次堆積されたクロム膜、酸化クロ

ム膜の積層膜からなり、直径が $55\mu\text{m}$ の円形開口部 2（開口パターン）を有する遮光膜 3 とを含む。上記石英基板の厚さは 6.35mm に限定されず、 1mm 以上 10mm 未満の範囲であれば構わない。

【0 0 2 6】

円形開口部 2 の端から $200\mu\text{m}$ 以内の領域には別の円形開口部はない。すなわち、円形開口部 2 を透過した光と、円形開口部 2 とは別の円形開口部を透過した光とが、同じ箇所を照射しないように設計されている。また、円形開口部 2 の内部には回折格子などの遮光領域はない。

【0 0 2 7】

フォトマスク 1 は、微細なパターンを持たないので、製造が容易である。したがって、フォトマスク 1 は、従来の微細な回折格子パターンを有すフォトマスクに比べて、製造コストはかからない。

【0 0 2 8】

次に、フォトマスク 1 を用いた露光装置の検査方法について説明する。

【0 0 2 9】

図 2 は、検査対象である周知の露光装置内に本実施形態のフォトマスク 1 をセットした状態を模式的に示す図である。フォトマスク 1 はピンホールカメラとして機能し、このフォトマスク 1 の機能により、照明光学系 1 3 の二次光源 1 4 の面と感光基板 1 8 の表面とは光学的に共役な状態になる。

【0 0 3 0】

図 2 において、1 1 は KrF エキシマレーザー光源や水銀ランプなどの光源を示しており、この光源 1 1 から発した露光光 1 2 は照明光学系 1 3 を経て整形され、二次光源 1 4 が形成される。

【0 0 3 1】

二次光源 1 4 の面上には図示しない複数のアパーチャマスクが設けられ、これらのアパーチャマスクの任意の一つを選択できるようになっている。したがって、二次光源 1 4 の照明形状は、選択したアパーチャマスクの開口部（アパーチャ）に対応したものとなる。

【0 0 3 2】

そして、二次光源 14 から発し、上記アパーチャマスクを通過した光は、コンデンサレンズ 15 を経て、マスクステージ 16（第 1 の設置手段）上に設置されたフォトマスク 1 をほぼ均一な照度で照明する。

【0033】

フォトマスク 1 を通過した光は投影光学系 17 により集光され、検査用の感光基板 18 上にフォトマスク 1 のパターンの像を投影する。感光基板 18 は基板ステージ 19（第 2 の設置手段）上に設置されている。ここでは、投影光学系 17 の縮小率 M を $1/4$ とする。縮小率 M は、通常、 $1/4$ または $1/5$ である。

【0034】

投影光学系 17 の内部には瞳の大きさを規定する絞りがあって、投影光学系 17 の中心軸から遠く離れた光はここで遮光される。したがって、絞りの縁付近を通るような光束を照射した場合、感光基板 18 には絞りの縁を表すパターンが転写される。二次光源 14 から発した光束が投影光学系 17 の瞳のどの領域を通過するかは、上記絞りの縁を表すパターンの転写位置から判明する。

【0035】

感光基板 18 は、直径 200 mm のシリコンウェハと、このシリコンウェハ上に塗布されたポジ型フォトレジストとを含む。ポジ型フォトレジストの代わりにネガ型フォトレジストを用いても構わない。本実施形態の検査用の感光基板 18 は、汎用品（シリコンウェハ、フォトレジスト）で構成されているので、コストはかからない。

【0036】

本実施形態では、露光装置を検査するときに、露光装置内にフォトマスク 1 をセットし、照明光学系 13 の二次光源 14 の面と感光基板 18 の表面とを光学的に共役の状態にする。

【0037】

なお、半導体デバイスパターンを露光するときは、二次光源 14 の面と投影光学系 17 の瞳面が光学的に共役、フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18 の表面が共役の関係にある。この場合、二次光源 14 の面の光強度分布とフォトマスク 1 のパターン面における像強度はフーリエ変換対の関係で表される。投影光

学系 17 の瞳面における光強度分布と感光基板 18 の表面における像強度についてもフーリエ変換対の関係で表される。

【0038】

本実施形態では、図 2 に示すように、フォトマスク 1 のパターン面の向きを、半導体デバイスパターンを露光するときの向き（図 3）とは逆に、すなわち裏返しにして設置する。これにより、フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18 の表面とを光学的に共役な状態にせずに済む。

【0039】

ここで、フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18 の表面とを光学的に共役な状態すると、フォトマスク 1 の情報（パターンの形状・寸法）は、感光基板 18 を現像して得られるレジストパターン上に反映される。照明軸ずれの検査に必要な情報は、照明光学系の情報と投影光学系の情報であり、フォトマスク 1 の情報は不要である。

【0040】

レジストパターン上にフォトマスク 1 の情報が反映された場合、フォトマスク 1 の情報と照明光学系および投影光学系の情報とを区別する必要がある、検査が煩雑になる恐れがある。したがって、検査を簡便に行うためには、レジストパターン上にフォトマスク 1 の情報を反映させない方が好ましい。

【0041】

なお、後述する第 5 の実施形態の場合のように、パターンが無いフォトマスク 1 つまり透明基板を用いる場合は、フォトマスク 1 と感光基板 18 とを光学的に共役な状態にしても問題はない。

【0042】

このようにフォトマスク 1 をマスクステージ 16 上に設置し、感光基板 18 を基板ステージ 19 上に設置し、そして、フォトマスク 1 および感光基板 9 が静止した状態で露光を行う。この露光は、二次光源 14 の照明形状が異なる二つの状態でそれぞれ 1 回ずつ行う、二重露光である。

【0043】

図 4 に、本実施形態で用いられる二次光源 14 の照明形状の平面図を示す。図

4 (a) は 1 回目の露光で使用される照明形状 21 を示し、図 4 (b) は 2 回目の露光で使用される照明形状 22 を示している。以下、これらの照明形状を用いた二重露光について詳説する。

【0044】

今、ある半導体デバイスのあるレイヤのパターンの露光を、 $NA = 0.55$ 、 $\sigma = 0.85$ の状態で行うとして、この状態における露光装置を検査する場合、1 回目の露光を $NA = 0.55$ 、 $\sigma = 0.85$ の状態（状態 1）で行う。さらに、この 1 回目の露光では、照明形状 21（二次光源 14 の中心の位置が現れる様な二次光源形状）を用いる。

【0045】

なお、 σ は照明光学系の出射側開口数 NA_{ill} と投影光学系 17 の入射側開口数 NA_{in} の比（ NA_{ill} / NA_{in} ）である。 $NA_{in} = NA \times M$ （ M は投影レンズの縮小率）であるから、 $\sigma = NA_{ill} / (NA \cdot M)$ とも表される。上記 NA （0.55）は投影光学系 17 の射出側開口数であり、 $\sigma = 0.85$ 、 $M = 1/4$ であるから、 $NA_{in} = 0.1375$ 、 $NA_{ill} = 0.116875$ である。したがって、 $NA_{in} > NA_{ill}$ である。

【0046】

2 回目の露光は、 NA を変化させないで、照明形状 21 を照明形状 22 に変更した状態（状態 2 とする）で行う。2 回目の露光の照明形状 22 による照明は輪帯照明であって、輪帯の外周の大きさが $\sigma = 1$ よりも大きく、かつ、輪帯の内周の大きさが $\sigma = 1$ よりも小さい輪帯照明である。さらに、2 回目の露光の照明形状 22 は、1 回目の露光の照明形状 21 と重ならないように選ばれている。

【0047】

ここで、輪帯の内周を形成する光と、該光が入射するフォトマスク 1 の面の法線とがなす角度 θ_{i2} （二次光源の内周に対応する光の入射角）を開口数の次元で表した数値 NA_{i2} （ $= \sin \theta_{in}$ ）は、 NA_{in} よりも小さくなる。したがって、本実施形態の場合、 $NA_{ill} > NA_{in} > NA_{i2}$ の不等式を満たす。

【0048】

1 回目の露光が $NA_{ill} = 0.116875$ であることを考慮し、2 回目露光

における輪帯照明の外周が $NA_{in}=0.1375$ よりも大である位置、内周が $NA_{in}=0.1375$ よりも小でかつ $NA_{ill}=0.116875$ よりも大である位置とする。具体的には、例えば、2回目の露光の輪帯照明の外周を $NA_{ill}=0.15$ 、内周を $NA_{ill}=0.125$ とする。この場合、感光基板18上に投影される二次光源14の像は、その外側が投影光学系17の絞りにより遮られたものとなる。言い換えると、投影光学系17の瞳の輪郭が感光基板18上に投影される。

【0049】

図5(a)は、1回目の露光時に二次光源14から発した光束の投影光学系17の瞳面における位置(光束位置)31および絞り位置32、図5(b)は、2回目の露光時に二次光源14から発した光束の投影光学系17の瞳面における位置(光束位置)33および絞り位置34を示している。

【0050】

瞳面においては、1回目の露光時に光束が通過する第1の領域と2回目の露光時に光束が通過する第2の領域とは重なっておらず、2回目の露光時の光束は絞りの輪郭を転写する。なお、状態1での露光と状態2での露光の順序を入れ替えても構わない。また、状態1の露光の露光量と状態2の露光の露光量はほぼ同じ値とする。

【0051】

1回目、2回目の露光が完了したら、感光基板18を露光装置から搬出して現像を行う。図6に、感光基板18上に形成されたレジストパターンを示す。レジストパターンは、中央に状態1の照明形状および輝度分布を反映したパターン(以下、内側パターンという。)41と、この内側パターン41の周囲にあり、状態2の照明形状および輝度分布を反映した輪帯状のパターン(以下、外側パターンという。)42とを含む構造となる。図において、43は外側パターン42の外周を表す円、すなわち投影光学系17の瞳を表す円(投影光学系17の絞りの縁の像)を示している。

【0052】

照明光学系の検査は上記レジストパターンを測定することにより行われる。ま

ず、二次光源 14 の形状と輝度分布の検査は、内側パターン 41 を計測することにより行われる。適切な露光量で露光していれば、高輝度の領域はフォトレジストが溶解し、低輝度の領域はフォトレジストが溶解しない状態となるため、露光量とレジストの溶解分布の関係をもとに照明形状と輝度分布が判明する。

【0053】

一方、照明軸ずれの検査は、内側パターン 41 の外周を表す円の中心と、外側パターン 42 の外周を表す円の中心とのずれを計測することにより行われる。照明軸ずれがない理想的な状態では二つの円の中心は一致する。

【0054】

一方、二つの円の中心のずれが 0 でない場合、二次光源 14 から発した光束が投影光学系 17 の瞳の中央からずれた位置を通過していることを意味する。これは、投影光学系 17 に入射する照明光が全体として斜めになっている状態（照明軸ずれの状態）であって、二つの円の中心ずれが大きいほど照明軸ずれが大きいことを意味する。

【0055】

ここで、フォトマスク 1 に入射する光の軸（正確には、フォトマスク 1 に入射する有限の広がりをもつ円錐状の光の中心軸）と、該光が入射するフォトマスク 1 の面の法線とのなす角（フォトマスク 1 に入射する有限の広がりをもつ円錐状の光の中心軸の傾き）を θ ラジアンとすると、照明軸ずれは、下式（1）によって評価することができる。

【0056】

$$\sin \theta = L \times \text{NA} / R \quad (1)$$

L：内側パターン 41 の外周を表す円と外側パターン 42 の外周を表す円の中心間の距離

R：投影光学系 17 の瞳を表す円の半径

L と R は測定可能であるので、式（1）を使えば、照明軸ずれの大きさ（ $\sin \theta$ ）が求められる。照明軸ずれの方向は、例えば、内側パターン 41 の外周を表す円の中心を原点とする X-Y 座標系における、外側パターン 42 の外周を表す円の中心の X 座標と Y 座標の値で評価することができる。

【0057】

本実施形態においては状態1、状態2の二つの状態で露光を行っているが、検査対象である状態は状態1であって、状態2の照明光学系13の検査をするわけではない。

【0058】

状態2の露光を行う目的は投影光学系17を状態1と同様に保ったまま露光することによって、状態1での絞りの位置（投影光学系17の情報）をレジストパターン上に投影することである。したがって、状態2においては、仮に多少の照明軸ずれが発生していたとしても、光束が絞りに投射される状態であれば、計測に関して問題はない。図7に、そのような場合に得られるレジストパターンの例を示す。

【0059】

以上述べたように、本実施形態によれば、検査に用いるフォトマスクとして、従来法において使用されているような微細な構造を有する製造が困難なフォトマスクを使用する代わりに、製造が容易なフォトマスク1を使用することで、製造コストをかけずに、露光装置の照明軸ずれの検査を行えるようになる。

【0060】

なお、本実施形態では、円形開口部2（ピンホール）の直径を $55\mu\text{m}$ としたが、円形開口部2の直径は $55\mu\text{m}$ に限定されるものではない。以下、この点についてさらに説明する。

【0061】

二次光源14の像を感光基板18上に正確に転写するためには、円形開口部2のサイズを適切にしなければならない。それは大きすぎると感光基板18上の像のぼけが大きくなり、逆に小さすぎても回折により像がぼけるからである。

【0062】

適切な円形開口部2のサイズは、円形開口部2からフォトマスク1の下面までの距離（フォトマスク1の透明基板の厚さ）と露光波長とが関係する。本発明者らは、フォトマスク1の厚さが 6.3mm で屈折率が約1.5、露光波長が 248nm （KrFエキシマレーザーの波長）の場合、円形開口部2の直径を $50\sim$

60 μm の範囲内に設定することにより、感光基板18上に解像度が良好な二次光源14の像を表すレジストパターンが得られることを実験により確認した。

【0063】

また、上記50～60 μm の直径条件から多少はずれた場合でも、直径が40 μm 以上80 μm 以下の大きさの円形開口部2を用いれば、精度が多少落ちる場合もあるが、実用上必要な精度は得られ、検査が可能であることも確認した。

【0064】

また、本実施形態のように、フォトマスク1の表面（上面）に円形開口部2を設置して露光装置を検査する場合、円形開口部2の半径 r は、円形開口部2からフォトマスク1の下面までの距離（透明基板の厚さ）を D 、露光波長を λ 、透明基板の屈折率を n とすると、

$$r = a (n D \lambda)^{1/2}$$

で与えられる。

【0065】

ここで、 a は0.5～0.6程度の値である。

【0066】

（第2の実施形態）

本実施形態が第1の実施形態の異なる点は、状態2の照明形状を、図8（b）に示すように、縦横4方向に輝度分布の極大をもつ照明形状52としたことにある。状態2の照明形状は、図8（a）に示すように、図4（a）の照明形状21と同様の円形の照明形状51である。

【0067】

この場合も、第1の実施形態と同様に、状態1の照明形状51と状態2の照明形状52との間に重なりが無いようにし、状態2の照明形状の最外周に対応する円53の大きさを $\sigma = 1$ よりも大きな状態、最内周に対応する円54の大きさを $\sigma = 1$ よりも小さい状態とする。

【0068】

この場合、取得されるレジストパターンは、図9に示すように、中央に状態1の照明形状・輝度分布を反映したパターン61と、このパターン61の周囲に有

り、状態2の照明形状および輝度分布を反映した4個のパターン62とを含む構造となる。

【0069】

パターン62の外周をなぞる仮想的な円63は、第1の実施形態の図6の円43に相当し、投影光学系17の瞳を表す円（投影光学系17の絞りの縁の像）を示している。

【0070】

露光装置の検査方法は、第1の実施形態における内側パターン41、外側パターン42、円43を、それぞれ、パターン61、パターン62、円63と読み替えることによって、第1の実施形態と同様に行える。

【0071】

なお、本実施形態では、縦横4方向に輝度分布の極大をもつ照明形状52としたが、原理的には3方向以上に輝度分布の極大をもつ照明形状であれば、測定は行える。

【0072】

（第3の実施形態）

本実施形態が第1の実施形態と異なる点は、第1に、図10に示すように、フォトマスク1のパターン面の向きを、半導体デバイスパターンを露光するときの向きと同じに設定することにある。本実施形態のフォトマスク1は、円形開口部の直径が $15\mu\text{m}$ であり、第1の実施形態の場合よりも小さくなっている。フォトマスク1に関し、その他の条件は第1の実施形態と同じである。

【0073】

第2に、このままでは、フォトマスク1のパターン面と感光基板18の表面とが光学的に共役の状態になるので、図10に示すように、感光基板18の表面位置を、マスクパターン転写時の位置P1から、感光基板1の表面の法線方向で投影光学系17から遠ざかる方向に $30\mu\text{m}$ 移動させ、フォトマスク1のパターン面と感光基板18の表面とを光学的に共役でない状態にする。

【0074】

このようにフォトマスク1と感光基板18を設置し、さらにフォトマスク1お

よび感光基板 18 を静止させた状態で露光を行う。この露光は、二次光源 14 の照明形状が異なる二つの状態でそれぞれ 1 回ずつ二重露光を行う。

【0075】

1 回目の露光における光学条件は、 $NA = 0.55$ 、 $NA_{ill} = 0.116875$ とし、2 回目の露光では、 $NA = 0.55$ 、外周が $NA_{ill} = 0.15$ であり、内周が $NA_{ill} = 0.125$ である輪帯照明とする。状態 1 の露光の露光量と状態 2 の露光の露光量はほぼ同じ値とする。

【0076】

1 回目、2 回目の露光が完了したら、感光基板 18 を露光装置から搬出して現像を行う。感光基板 18 上に形成されるレジストパターンは、図 6 のそれと相似形のものとなる。上記レジストパターンは、中央に形成された円盤状のパターンと、この円盤状のパターンの周囲にある輪帯状のパターンとを含む構造となる。照明光学系の検査は、第 1 の実施形態に記載した方法と同様の手順で行われる。

【0077】

なお、本実施形態では、感光基板 18 を投影光学系 17 から遠ざかる方向に移動させたが、投影光学系 17 に近づく方向に移動させて、フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18 の表面とを光学的に共役でない状態にすることでも、同様の効果が得られる。

【0078】

なお、本実施形態では、フォトマスク 1 の円形開口部（ピンホール）の直径を $15\mu\text{m}$ としたが、円形開口部の直径は $15\mu\text{m}$ に限定されるものではない。以下、この点についてさらに説明する。

【0079】

二次光源 14 の像を感光基板 18 上に正確に転写するためには、円形開口部 2 のサイズを適切にしなければならない。それは大きすぎると感光基板 18 上の像のぼけが大きくなり、逆に小さすぎても回折により像がぼけるからである。

【0080】

適切な円形開口部 2 のサイズは、フォトマスク 1 のパターン面から感光基板 18 の表面までの距離と露光波長に関係する。本発明者らは、感光基板 18 の P 1

からのずらし距離（デフォーカス距離）が約 $30\ \mu\text{m}$ 、露光波長が $248\ \text{nm}$ の場合、フォトマスク 1 の円形開口部の直径を $10\sim 15\ \mu\text{m}$ の範囲内に設定することにより、感光基板 18 上に解像度が良好な二次光源 14 の像を表すレジストパターンが得られることを実験により確認した。

【0081】

また、上記 $10\sim 15\ \mu\text{m}$ の直径条件から多少はずれた場合でも、フォトマスク 1 の円形開口部の直径が $1\ \mu\text{m}$ 以上 $20\ \mu\text{m}$ 以下の範囲であれば、精度が多少落ちる場合もあるが、実用上必要な精度は得られ、検査が可能であることも確認した。

【0082】

（第 4 の実施形態）

図 11 は、本発明の第 4 の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図である。本実施形態では、フォトマスク 1 のパターン面の向きを裏返して設置するとともに、感光基板 18' として図 12 に示す構造のものを使用する。

【0083】

感光基板 18' は、露光光（露光波長）に対してほぼ透明な材質、図 12 に示すように、熔融石英からなる厚さが $1\ \text{mm}$ の薄い透明基板 70 と、この透明基板 70 の表面に設けられ、露光光（露光波長）の一部が透過する程度の透明度を有するフォトレジスト（感光剤）71 と、透明基板 70 の裏面に設けられ、該裏面を鏡面化して露光光を反射するためのクロム膜（反射膜）72 とを含む。フォトレジスト 71 は塗布法で形成され、クロム膜 72 は蒸着法で形成される。

【0084】

フォトマスク 1 は、第 1 の実施形態（図 1）で説明したように、円形開口部 2 を有するが、その直径はここでは $80\ \mu\text{m}$ である。フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18' の表面とは光学的に共役の状態にある。

【0085】

第 3 の実施形態に記した光学条件で 1 回目および 2 回目の露光を行う。図 12 に示すように、感光基板 18' の表面に到達した露光光はフォトレジスト 71 を感光してフォトマスク 1 のパターンの像（第 1 の像）を形成するとともに、フォ

トレジスト 71 および透明基板 70 を通過してクロム膜 72 (感光基板 18' の裏面の鏡面) で反射し、再び感光基板 18' の表面に到達して、フォトレジスト 71 を感光して像 (第 2 の像) を形成する。

【0086】

ここで、フォトマスク 1 のパターン面と感光基板 18' の表面とは光学的に共役の状態にあるので、フォトマスク 1 のパターン面と第 1 の像が形成された領域の感光基板 18 の表面とは光学的に共役の状態にある。

【0087】

しかし、感光基板 18' の裏面で反射した光の光路は、感光基板 18' の表面で反射した光の光路よりも長いため、フォトマスク 1 のパターン面と第 2 の像が形成された領域の感光基板 18 の表面とは光学的に共役の状態にはない。

【0088】

すなわち、第 2 の像を形成する光は、実質的に、第 3 の実施形態と同様に、マスクパターン転写時の位置から投影光学系 17 から遠ざかる方向に移動させた感光基板 18 を露光することになる。

【0089】

1 回目、2 回目の露光が完了したら、感光基板 18 を露光装置から搬出して現像を行う。図 13 に、感光基板 18' 上に形成されるレジストパターンを示す。レジストパターンは、中央にフォトマスク 1 のパターンの縮小像 (第 1 の像) に対応したパターン 81 と、このパターン 81 の周囲に有り、感光基板 18' の裏面の鏡面で反射した光により感光して形成された第 2 の像に対応したパターン 82 とを含む構造となる。

【0090】

図において、83 はパターン 82 の外周を表す円、すなわち投影光学系の絞りの縁の像を示している。また、二つのパターン 82 のうち内側の円形パターンが図 6 のパターン 41 に相当し、外側の輪帯パターンが図 6 のパターン 42 に相当する。

【0091】

パターン 82 について第 1 の実施形態に記載した方法と同様の手順で照明光学

系の検査が行われる。このとき、パターン 81 の直径はパターン 82 の $1/10$ 以下となるので、パターン 82 の解析においては障害とならない。

【0092】

(第 5 の実施形態)

本実施形態が第 1 の実施形態と異なる点は、フォトマスク 1 の代わりに、図 14 に示すようなレンズアレイ 90 を用いて、照明光学系 13 の二次光源 14 の面と感光基板 18 の表面とを光学的に共役な状態にすることにある。また、レンズアレイ 90 は露光装置に組み込まれたものである。

【0093】

レンズアレイ 90 は、露光光（露光波長）に対して透明なレンズホルダ 91 と、このレンズホルダ 91 上にマトリクス状に固定して設置された複数のレンズ 92 とを含む。図 14 (a) は側面図、図 14 (b) は上平面図を示している。

【0094】

レンズホルダ 91 は、図示しない駆動機構により制御されるアーム 93（待避手段）により、支持されて光路中に挿入または光路から退避されるようになっている。これにより、レンズアレイ 90 は配置された半導体デバイスパターンの露光の際には光路外に退避され、そして、照明光学系の検査をする際には、図 15 に示すように、露光光の光路中に挿入される。

【0095】

このとき、レンズホルダ 91 は、レンズ 92 が配置された面（レンズ面）が感光基板 18 の表面と平行となるように、フォトマスク 1 の表面の上方に挿入される。なお、ここでは、フォトマスク 1 はパターンを含まない単なる透明基板であり、省略可能である。

【0096】

さらに、レンズアレイ 90 は、フォトマスクの表面の上方に該表面に対して垂直な方向に、所定距離離れた位置に設置される。所定距離は、露光波長の光に対するレンズ 92 の焦点距離もしくは該所定距離に略一致する距離（焦点距離と実質的に同じ距離）である。このような位置にレンズアレイ 90 を設置することにより、鮮明なレジストパターン（像）を感光基板 18 に形成できるようになる。

【0097】

この状態では、二次光源14の面とフォトマスク1の表面（下面）とが光学的に共役となり、さらにフォトマスクの裏面（下面）と感光基板18の裏面とが光学的に共役となるため、二次光源14の面と感光基板18の表面とは光学的に共役となる。

【0098】

なお、フォトマスク1（透明基板）を用いない場合、フォトマスク1（透明基板）が仮想的にあるとした場合に、該仮想的なフォトマスク1（透明基板）の表面に焦点が位置するように、レンズアレイ90は設置される。フォトマスク1は省略可能であるが、レンズアレイ90の位置決めの基準となるフォトマスク1が実際にあった方が、位置決めを容易に正確に行える。

【0099】

レンズアレイ90を挿入した状態で、第1の実施形態に記した露光方法を実施し、レジストパターンを取得し、そして、第1の実施形態と同様に、レジストパターンを解析することで、照明光学系の検査を行える。

【0100】

また、本実施形態によれば、露光装置の照明光学系13の検査を行うために必要な機構である、レンズアレイ90およびそれを駆動するための図示しない駆動機構を装置自身に持たせることによって、検査を行う毎に検査に必要な機構を用意する場合に比べて、簡便に検査を行えるようになる。

【0101】

なお、図14、図15には、厚みのあるレンズ92が描かれているが、円形開口やゾンプレートを使用しても同様の効果が得られる。

【0102】

また、本実施形態では、レンズアレイ90を使用しているので、露光フィールド全体の検査を一括して行えるが、1個のレンズを用いても該レンズの配置位置を変えながら複数回の露光を行い、その後、現像を行うことでも、同様の検査結果は得られる。レンズアレイ90を使用した場合には、短時間で検査を行え、一方、1個のレンズを使用した場合には、装置コストの削減化が可能となる。

【0103】

図16に、レンズアレイ90の変形例を示す。この変形例のレンズアレイ90'は、レンズ92が設けられた領域が露光光に対して透明領域、レンズ92が設けられていない領域が露光光に対して遮光領域となっている、レンズホルダ91を含む。

【0104】

このようなレンズアレイ90'は、レンズホルダ91として、例えば、透明基板と、この透明基板上に形成され、レンズ92が設けられる領域に開口部を有する遮光膜とを含むものを用いることで実現できる。

【0105】

このようなレンズアレイ90'を使用すれば、レンズ92が設けられた領域のレンズホルダ91の表面に照射された露光光のみが、感光基板18レンズ92に届く。そのため、不要な露光光が迷光となって感光基板18に届くのが防止されるので、該迷光による測定パターンの形状劣化を防止でき、より精度の高い測定が可能となる。

【0106】

(第6の実施形態)

図17は、本発明の第6の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図である。

【0107】

本実施形態が第5の実施形態と異なる点は、レンズアレイ90の挿入位置を照明光学系12と投影光学系17との間、具体的にはフォトマスク1と投影光学系17との間にしたことにある。この場合は、フォトマスク1から距離が、露光波長の光に対するレンズ92の焦点距離の位置もしくはほぼ一致する位置に、レンズアレイ90を挿入する。

【0108】

このような位置にレンズアレイ90を挿入することで、第5の実施形態と同様の測定が可能となる。また、第5の実施形態と同様の変形例も可能である。

【0109】

(第7の実施形態)

図18は、本発明の第7の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図である。

【0110】

本実施形態が第7の実施形態と異なる点は、レンズアレイ90の挿入位置を投影光学系17と感光基板18との間にしたことにある。この場合は、露光波長の光に対するレンズ92の焦点が、感光基板18の表面もしくは表面近傍となる位置に、レンズアレイ90を挿入することで、第5の実施形態と同様の測定が可能となる。また、第5の実施形態と同様の変形例も可能である。

【0111】

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、照明光学系の二次光源の面と感光基板の表面とを光学的に共役な状態にするために、フォトマスク（ピンホールカメラ）1やレンズアレイ90を用いたが、他のパターン部材を用いても構わない。

【0112】

さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題を解決できる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。

【0113】

その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施できる。

【0114】**【発明の効果】**

以上詳説したように本発明によれば、コストをかけずに照明軸ずれの検査を行える露光装置の検査方法および露光装置を実現できるようになる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の第1の実施形態に係る露光装置の検査方法において使用するフォトマ

スクを示す平面図

【図 2】

検査対象である周知の露光装置内に同フォトマスクをセットした状態を模式的に示す図

【図 3】

半導体デバイスパターンを露光するときのフォトマスクのパターン面の向きを示す図

【図 4】

第 1 の実施形態で用いられる二次光源の照明形状を示す平面図

【図 5】

1 回目および 2 回目の露光時に二次光源から発した光束の投影光学系の瞳面における位置および絞り位置を示す図

【図 6】

図 4 の二次光源の照明形状を用いた場合に感光基板上に形成されるレジストパターンを示す平面図

【図 7】

変形例の二次光源の照明形状を用いた場合に感光基板上に形成されるレジストパターンを示す平面図

【図 8】

本発明の第 2 の実施形態に係る二次光源の照明形状を示す平面図

【図 9】

図 8 の二次光源の照明形状を用いた場合に感光基板上に形成されるレジストパターンを示す平面図

【図 10】

本発明の第 3 の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図

【図 11】

本発明の第 4 の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図

【図 12】

同露光装置の検査方法において使用する感光基板を示す断面図

【図 1 3】

同感光基板上に形成されるレジストパターンを示す平面図

【図 1 4】

本発明の第 5 の実施形態に係るレンズアレイを示す側面図および上面図

【図 1 5】

照明光学系の検査をするために同レンズアレイが光経路中に挿入された露光装置を示す図

【図 1 6】

図 1 4 のレンズアレイの変形例を示す側面図および平面図

【図 1 7】

本発明の第 6 の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図

【図 1 8】

本発明の第 7 の実施形態に係る露光装置の検査方法を説明するための図

【図 1 9】

露光装置の照明軸ずれの影響を説明するための図

【図 2 0】

従来の照明軸ずれの計測方法で使用するグレーティングピンホールを示す平面図

【図 2 1】

従来の照明軸ずれの計測方法で形成される感光基板上のパターンを示す平面図

【符号の説明】

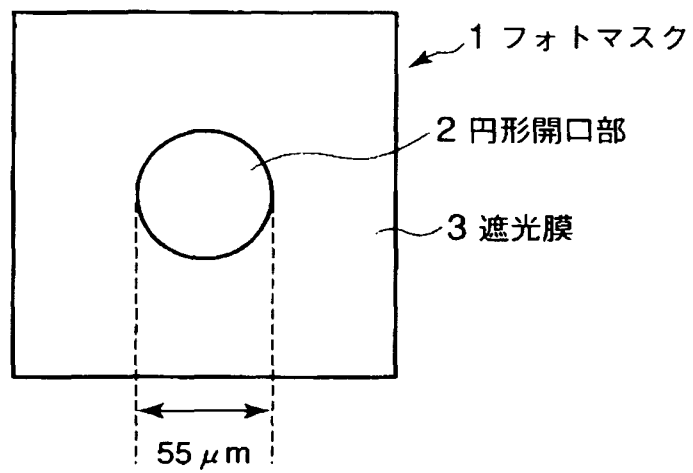
- 1…フォトマスク（パターン部材）
- 2…円形開口部
- 3…遮光膜
- 1 1…光源
- 1 2…露光光
- 1 3…照明光学系
- 1 4…二次光源
- 1 5…コンデンサレンズ

- 1 6…マスクステージ（第 1 の設置手段）
- 1 7…投影光学系
- 1 8, 1 8' …感光基板
- 1 9…基板ステージ（第 2 の設置手段）
- 2 1, 2 2…照明形状
- 3 1, 3 3…光束位置
- 3 2, 3 4…絞り位置
- 4 1…内側パターン
- 4 2…外側パターン
- 4 3…投影光学系の絞りの縁の像
- 5 1, 5 2…照明形状
- 6 1, 6 2…パターン
- 6 3…仮想的な円
- 7 0…透明基板
- 7 1…フォトレジスト
- 7 2…クロム膜（反射膜）
- 8 1, 8 2…パターン
- 8 3…投影光学系の絞りの縁の像
- 9 0, 9 0' …レンズアレイ（パターン部材）
- 9 1…レンズホルダ
- 9 2…レンズ
- 9 3…アーム（待避手段）

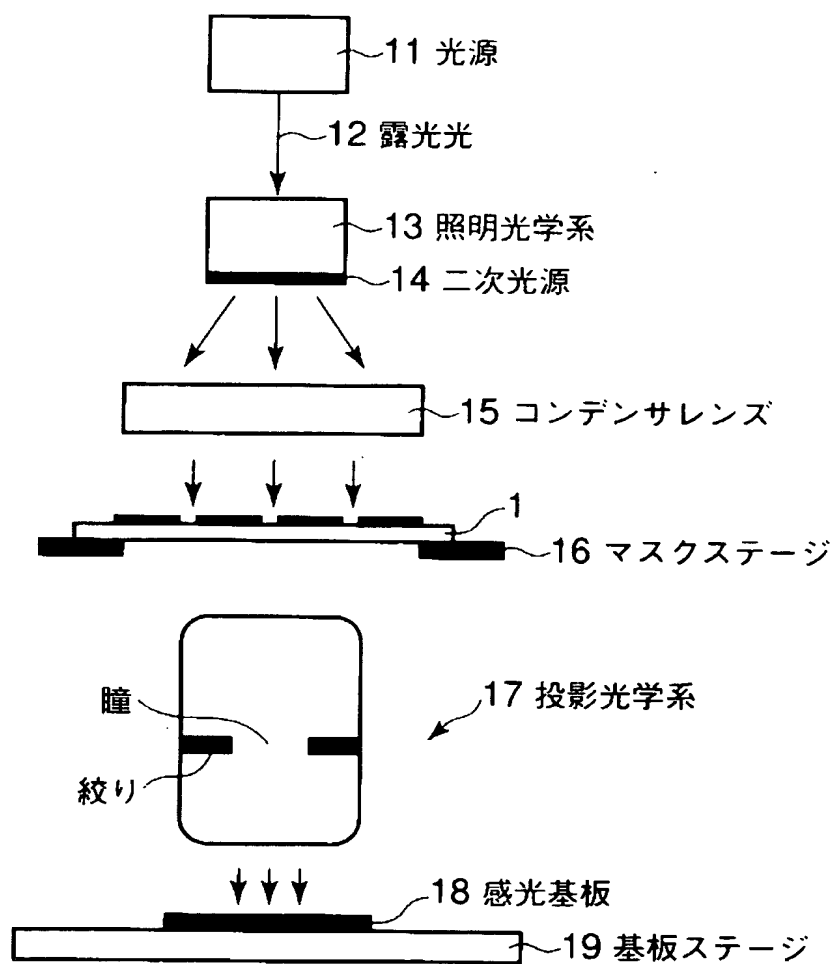
【書類名】

図面

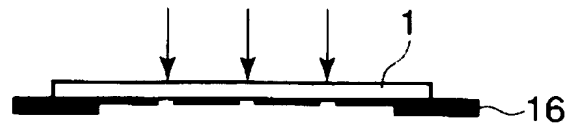
【図 1】



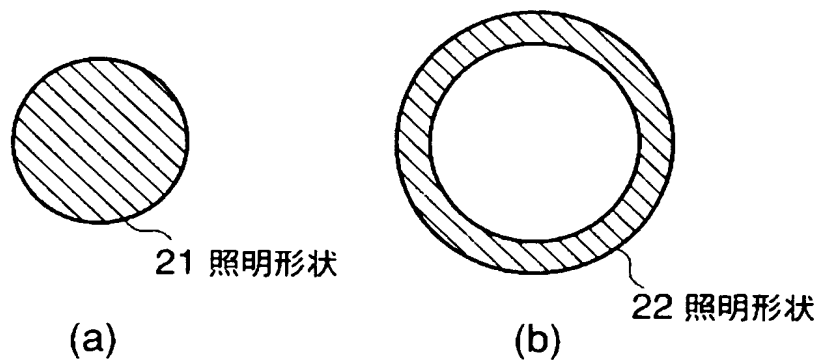
【図 2】



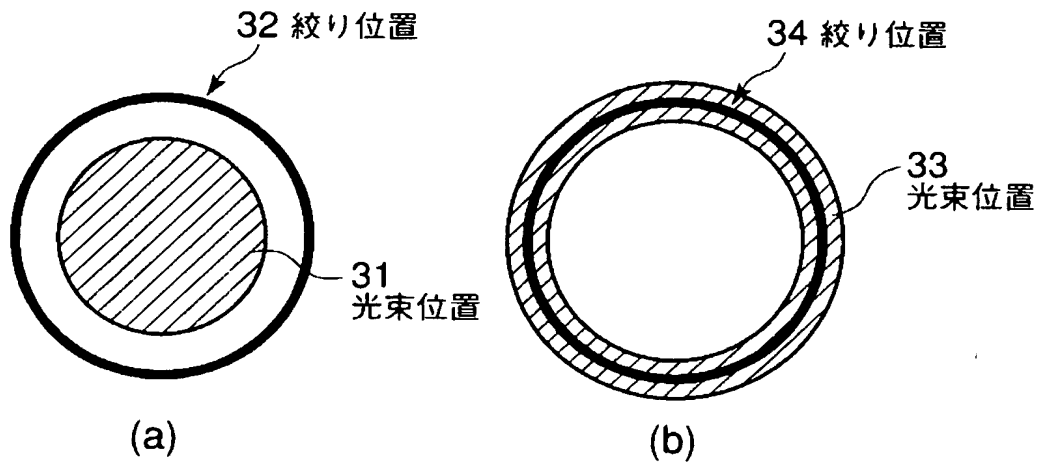
【図 3】



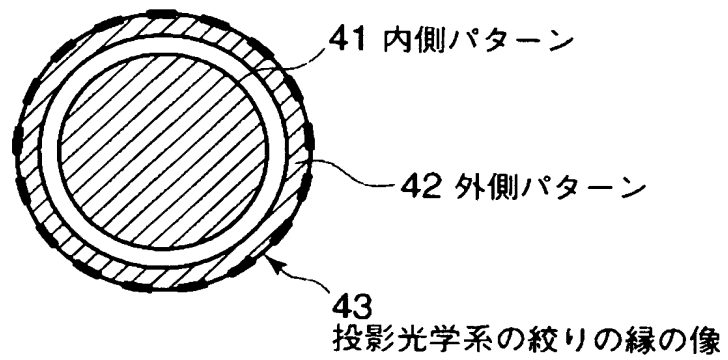
【図 4】



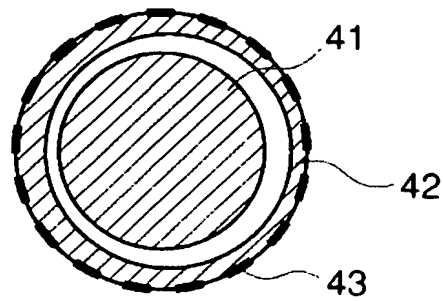
【図 5】



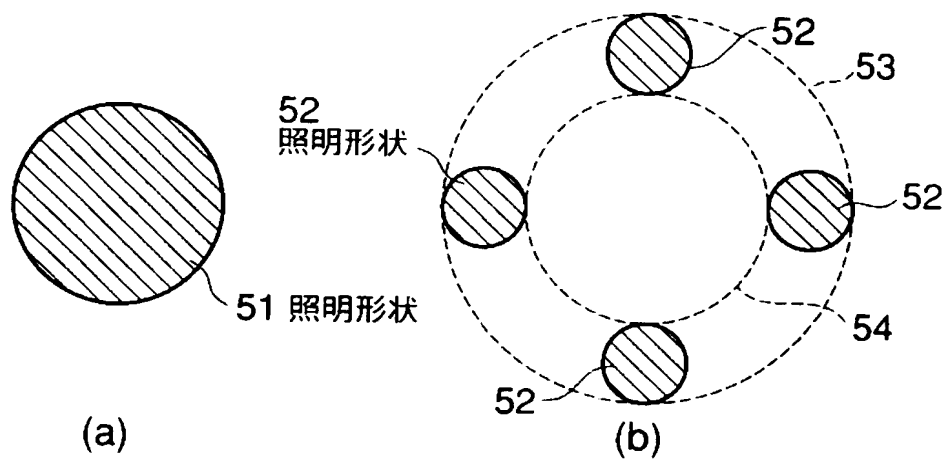
【図 6】



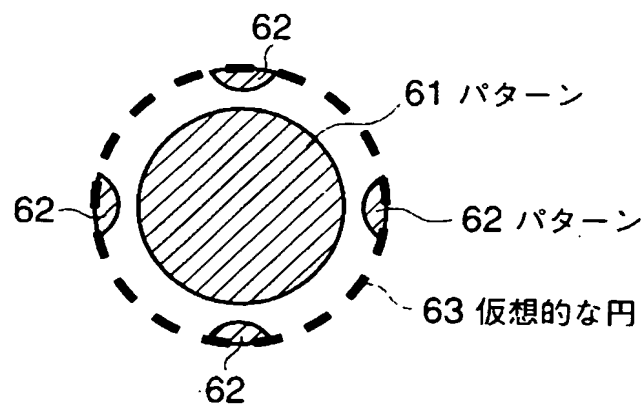
【図 7】



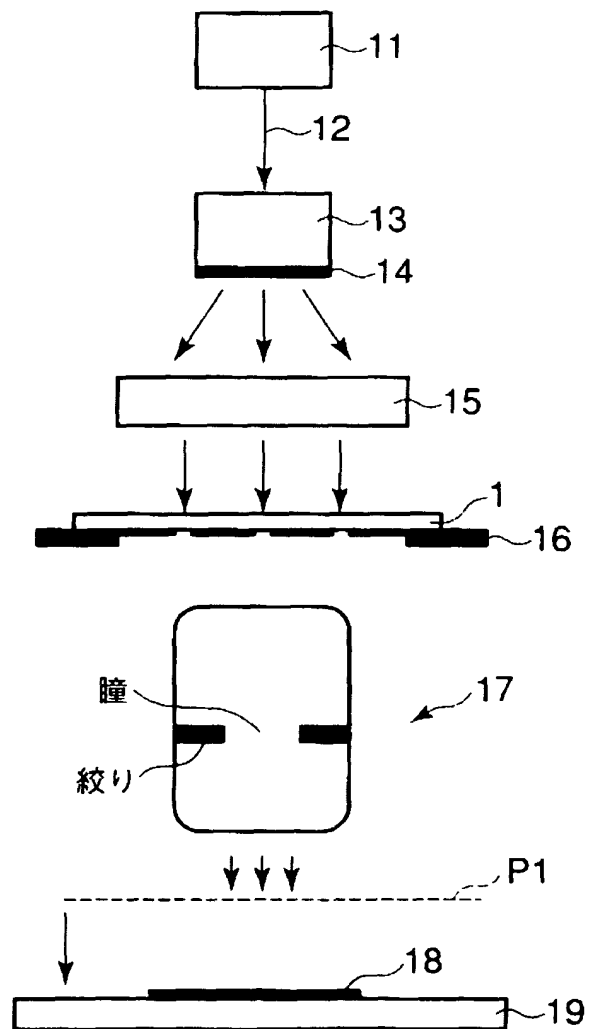
【図 8】



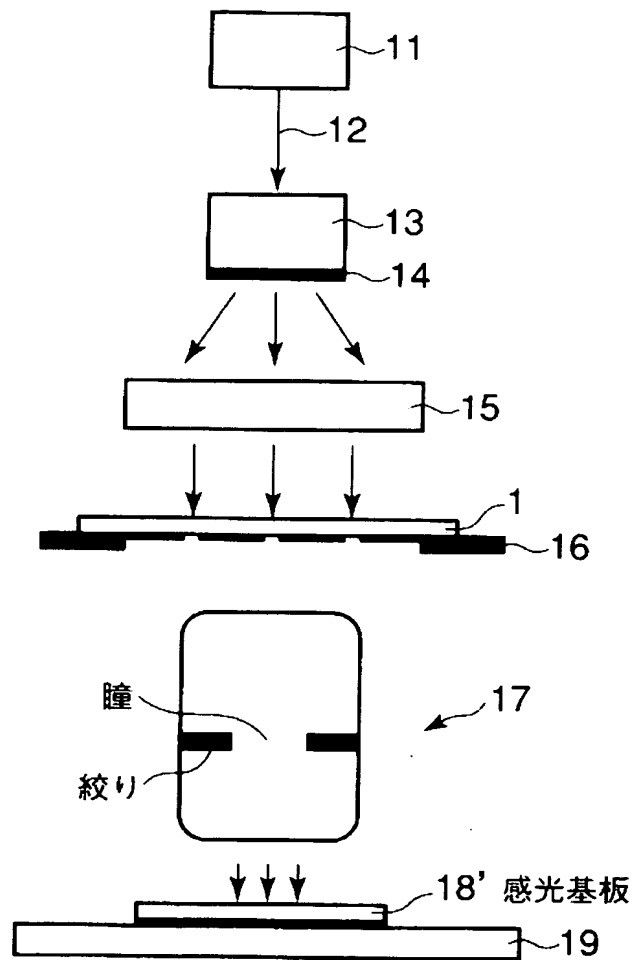
【図 9】



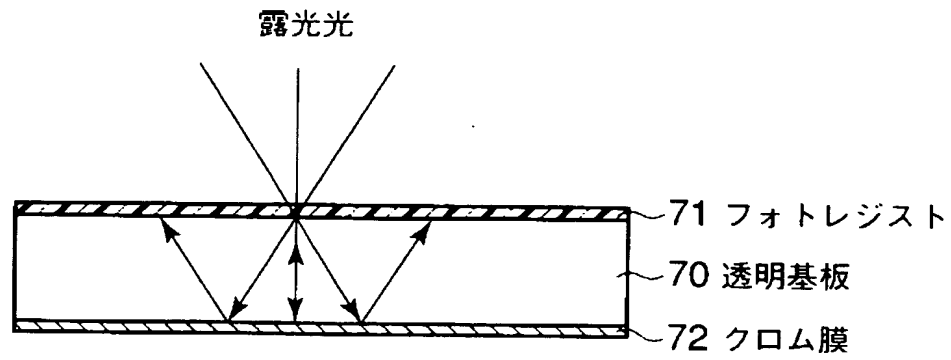
【図 10】



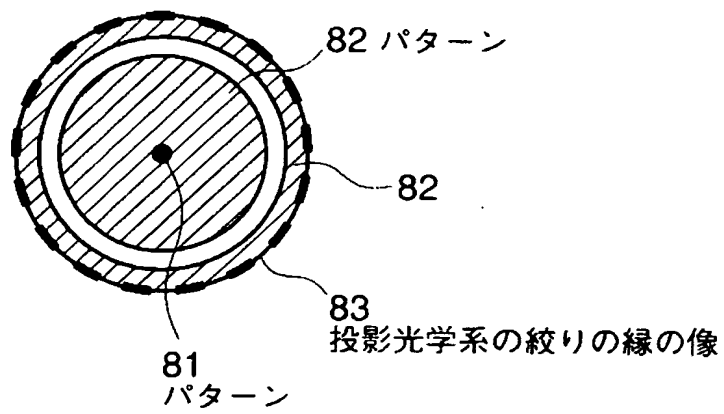
【図 11】



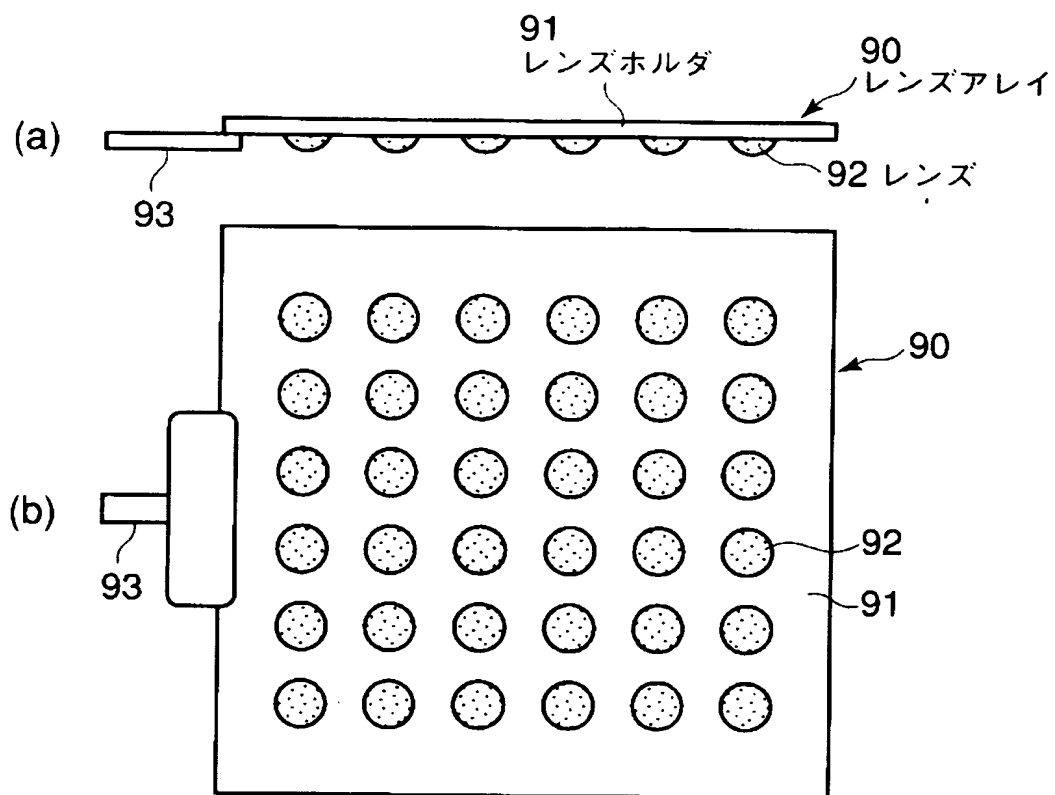
【図 1 2】



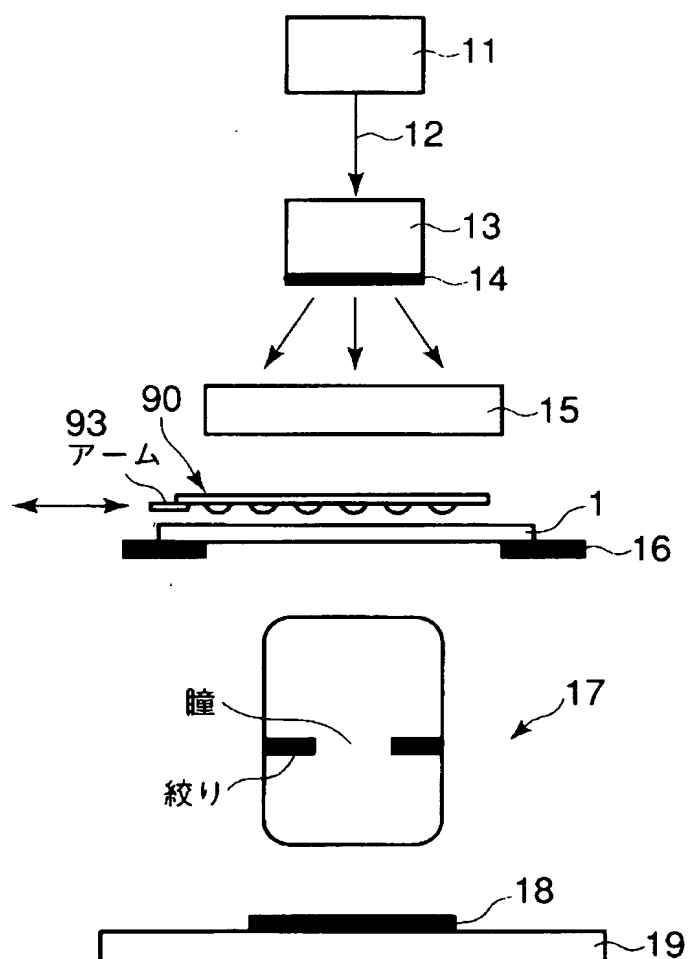
【図 1 3】



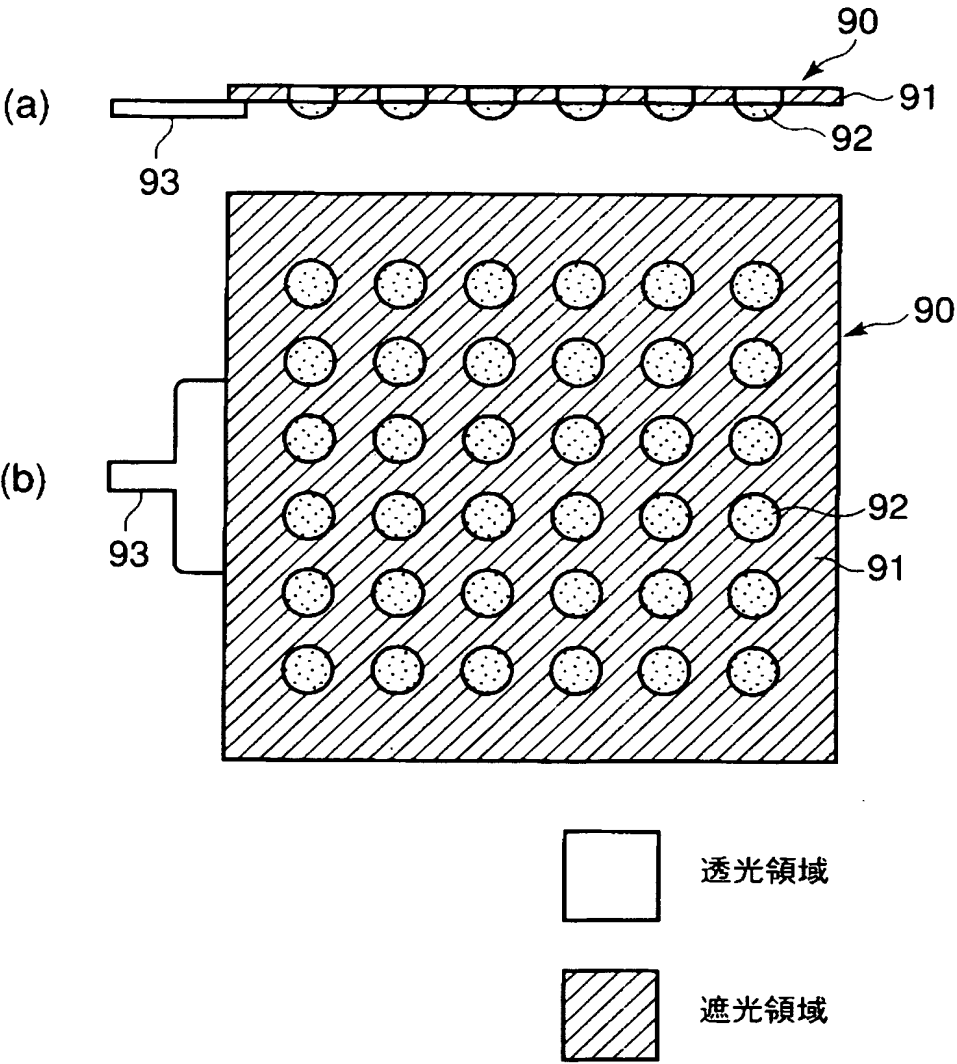
【図 14】



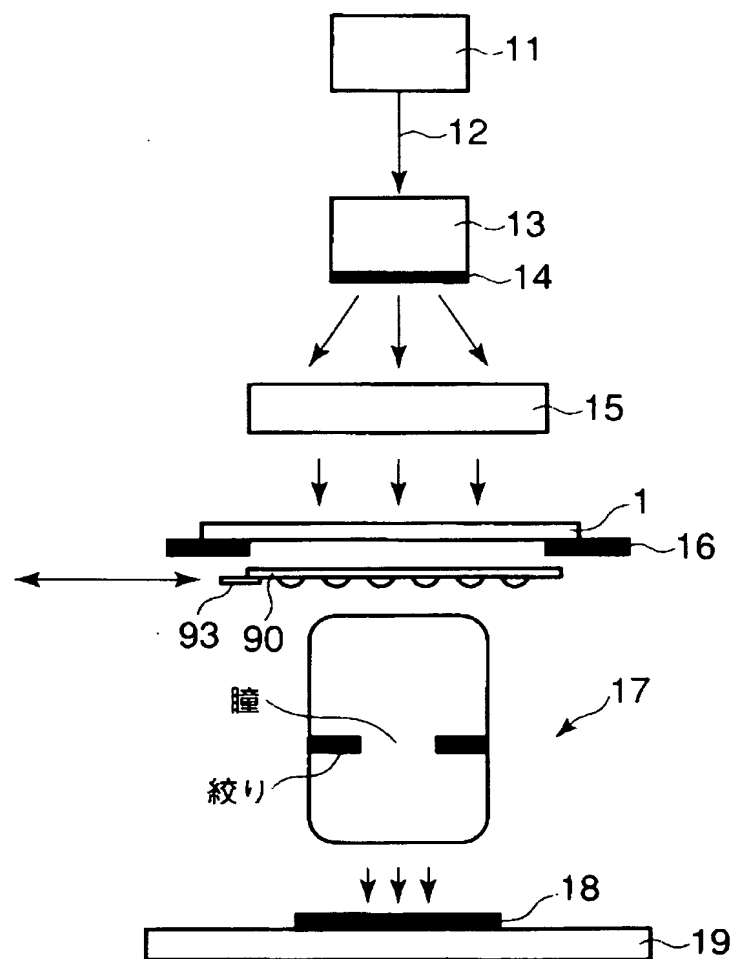
【図 15】



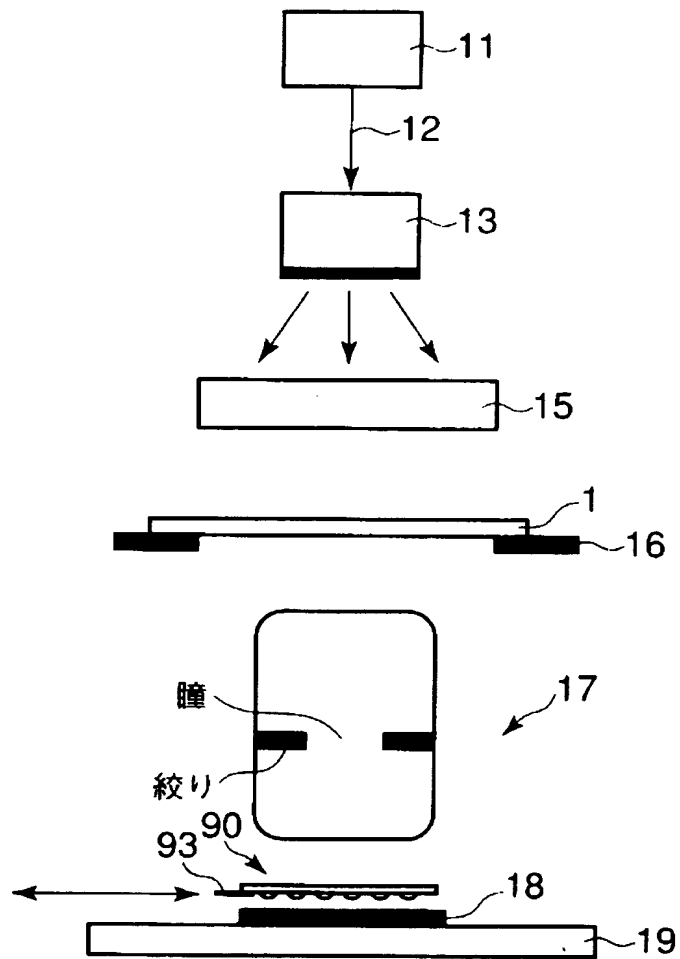
【図 16】



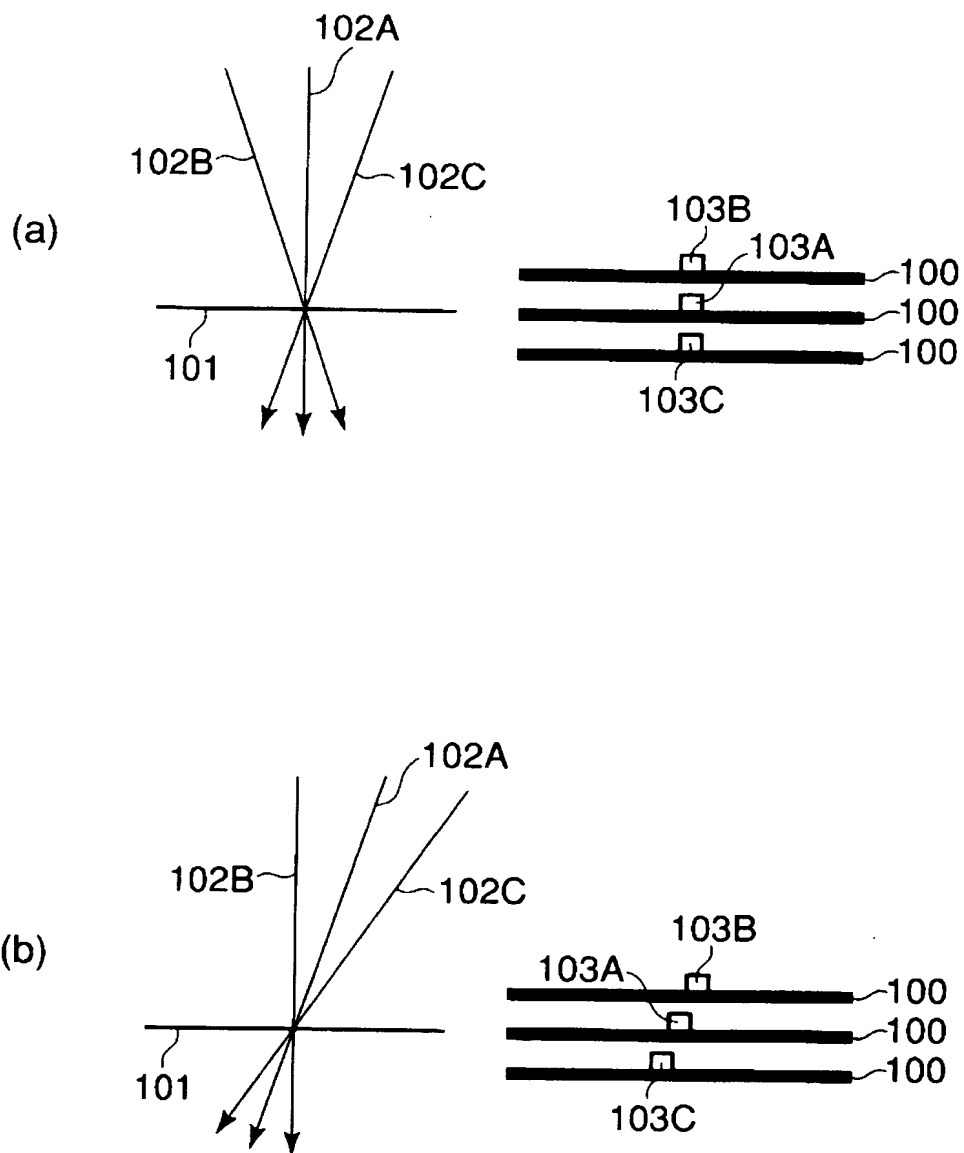
【図 17】



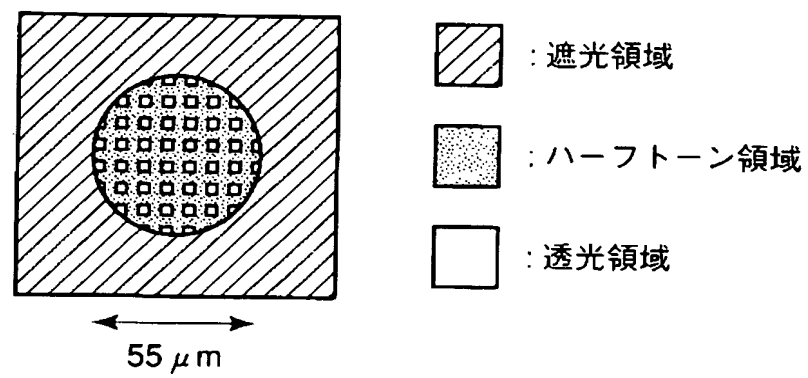
【図 18】



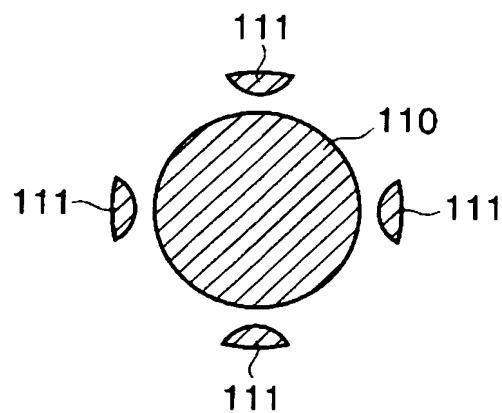
【図 19】



【図 20】



【図 21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コストをかけずに露光装置の照明軸ずれの検査を行うこと。

【解決手段】 フォトマスク 1 により、感光基板 18 の表面と二次光源 14 の面とを光学的に共役な状態にし、この状態で、投影光学系 17 の瞳の端を含まない領域、および該領域と重ならない、投影光学系 17 の瞳の端を含む領域を照明して感光基板 18 を露光し、その後、感光基板 18 を現像して得られるパターンに基づいて照明軸ずれを検査する。

【選択図】 図 2

特願 2002-255210

出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

- | | |
|----------|----------------|
| 1. 変更年月日 | 2001年 7月 2日 |
| [変更理由] | 住所変更 |
| 住 所 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 |
| 氏 名 | 株式会社東芝 |
| | |
| 2. 変更年月日 | 2003年 5月 9日 |
| [変更理由] | 名称変更 |
| | 住所変更 |
| 住 所 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 |
| 氏 名 | 株式会社東芝 |